

## RF Power MOSFET Transistor 200W, 2-175MHz, 28V

M/A-COM Products  
Released; RoHS Compliant

### Features

- N-Channel enhancement mode device
- DMOS structure
- Lower capacitances for broadband operation
- High saturated output power
- Lower noise figure than bipolar devices

### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT 25° C

Parameter	Symbol	Rating	Units
Drain-Source Voltage	$V_{DS}$	65	V
Gate-Source Voltage	$V_{GS}$	20	V
Drain-Source Current	$I_{DS}$	24	A
Power Dissipation	$P_D$	62.5	W
Junction Temperature	$T_J$	200	°C
Storage Temperature	$T_{STG}$	-55 to +150	°C
Thermal Resistance	$\theta_{JC}$	2.8	°C/W

### TYPICAL DEVICE IMPEDANCE

F (MHz)	$Z_{IN}$ ( $\Omega$ )	$Z_{LOAD}$ ( $\Omega$ )
30	17.5 - j13.0	16.0 - j2.5
50	15.0 - j15.5	15.0 - j4.0
100	8.0 - j14.0	12.0 - j6.0
200	5.5 - j8.0	9.25 - j6.0

$V_{DD} = 28V, I_{DQ} = 100mA, P_{OUT} = 20 W$

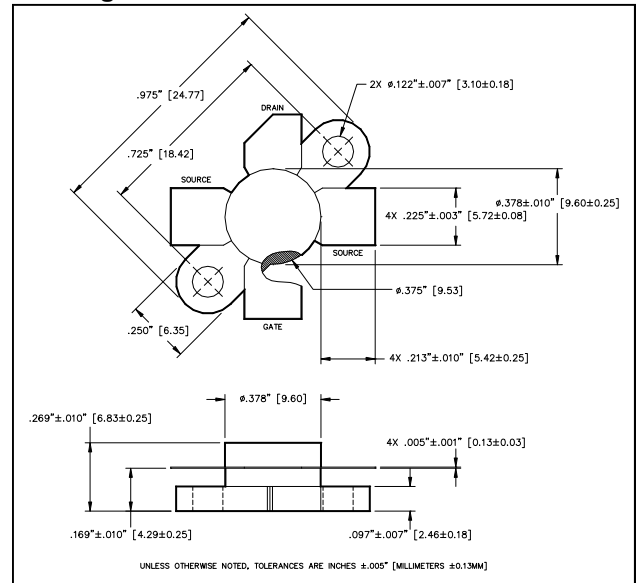
$Z_{IN}$  is the series equivalent input impedance of the device from gate to source.

$Z_{LOAD}$  is the optimum series equivalent load impedance as measured from drain to ground.

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT 25°C

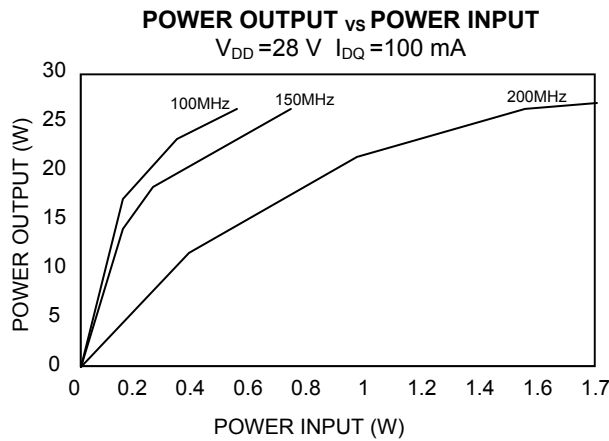
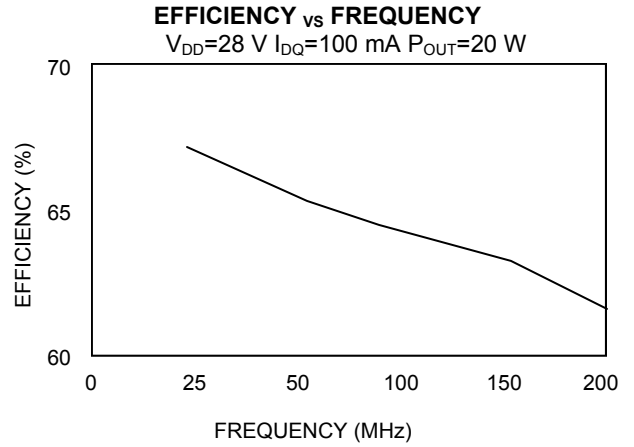
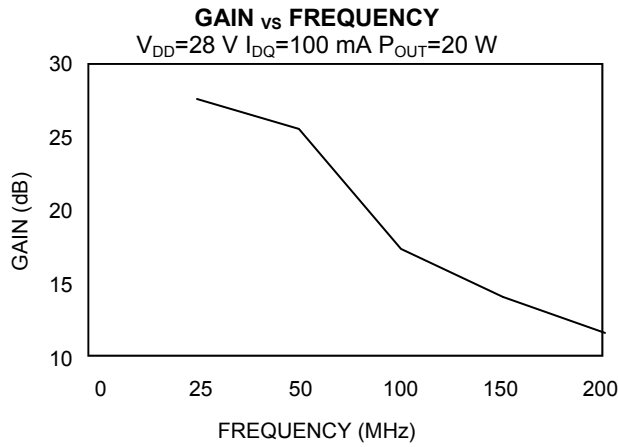
Parameter	Symbol	Min	Max	Units	Test Conditions
Drain-Source Breakdown Voltage	$BV_{DSS}$	65	-	V	$V_{GS} = 0.0 V, I_{DS} = 5.0 mA$
Drain-Source Leakage Current	$I_{DSS}$	-	1.0	mA	$V_{DS} = 28.0 V, V_{GS} = 0.0 V$
Gate-Source Leakage Current	$I_{GSS}$	-	1.0	$\mu A$	$V_{GS} = 20.0 V, V_{DS} = 0.0 V$
Gate Threshold Voltage	$V_{GS(TH)}$	2.0	6.0	V	$V_{DS} = 10.0 V, I_{DS} = 100.0 mA$
Forward Transconductance	$G_M$	500	-	S	$V_{DS} = 10.0 V, I_{DS} = 100.0 mA, \Delta V_{GS} = 1.0V, 80 \mu s$ Pulse
Input Capacitance	$C_{ISS}$	-	45	pF	$V_{DS} = 28.0 V, F = 1.0 MHz$
Output Capacitance	$C_{OSS}$	-	40	pF	$V_{DS} = 28.0 V, F = 1.0 MHz$
Reverse Capacitance	$C_{RSS}$	-	8	pF	$V_{DS} = 28.0 V, F = 1.0 MHz$
Power Gain	$G_P$	13	-	dB	$V_{DD} = 28.0 V, I_{DQ} = 100 mA, P_{OUT} = 20 W F = 175 MHz$
Drain Efficiency	$\eta_D$	60	-	%	$V_{DD} = 28.0 V, I_{DQ} = 100 mA, P_{OUT} = 20 W F = 175 MHz$
Load Mismatch Tolerance	VSWR-T	-	30:1	-	$V_{DD} = 28.0 V, I_{DQ} = 100 mA, P_{OUT} = 20 W F = 175 MHz$

### Package Outline

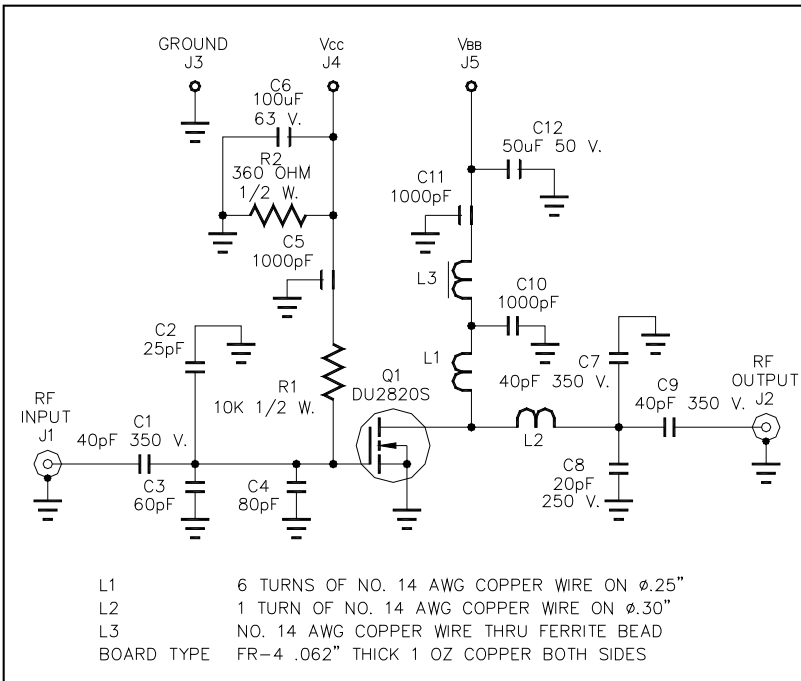


LETTER DIM	MILLIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	24.64	24.89	.970	.980
B	18.29	18.54	.720	.730
C	20.07	20.83	.790	.820
D	9.47	9.73	.373	.383
E	6.22	6.48	.245	.255
F	5.64	5.79	.222	.228
G	2.92	3.30	.115	.130
H	2.29	2.67	.090	.105
J	4.04	4.55	.159	.179
K	6.58	7.39	.259	.291
L	.10	.15	.004	.006

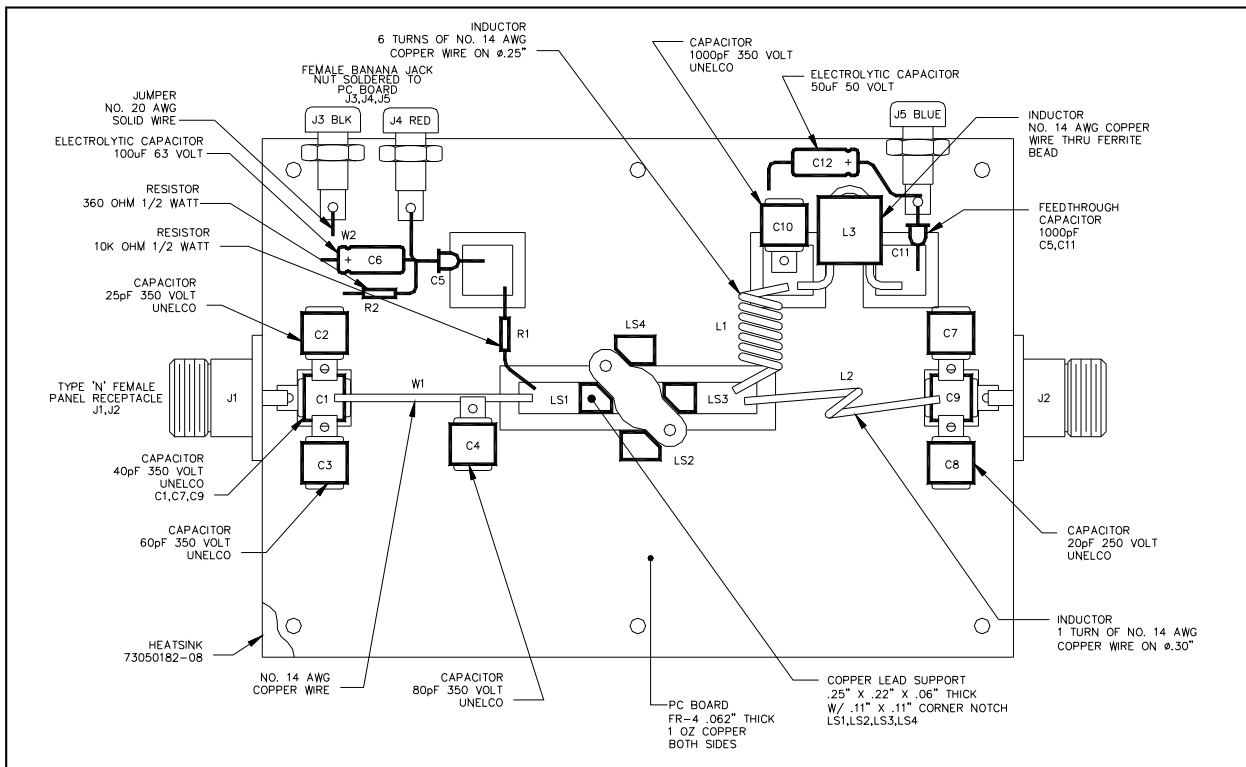
**Typical Broadband Performance Curves**



### TEST FIXTURE SCHEMATIC



### TEST FIXTURE ASSEMBLY



**ADVANCED:** Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions is considering for development. Performance is based on target specifications, simulated results, and/or prototype measurements. Commitment to develop is not guaranteed.  
**PRELIMINARY:** Data Sheets contain information regarding a product M/A-COM Technology Solutions has under development. Performance is based on engineering tests. Specifications are typical. Mechanical outline has been fixed. Engineering samples and/or test data may be available. Commitment to produce in volume is not guaranteed.

- **North America** Tel: 800.366.2266 / Fax: 978.366.2266
- **Europe** Tel: 44.1908.574.200 / Fax: 44.1908.574.300
- **Asia/Pacific** Tel: 81.44.844.8296 / Fax: 81.44.844.8298

Visit [www.macontech.com](http://www.macontech.com) for additional data sheets and product information.

M/A-COM Technology Solutions Inc. and its affiliates reserve the right to make changes to the product(s) or information contained herein without notice.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.